19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭55—38869

C 09 K G 02 F G 09 F	3/34	識別記 号 101	庁内整理番号 7229—4H	❸公開 昭和55年(1980) 3月18日		
	1/13 9/00 9/35		7348—2H 7129—5C 7013—5C	発明の数 5 審査請求 未	請求	

(全 6 頁)

∞液晶セルおよびその駆動方法

②特 願 昭54-78996

②出 願 昭54(1979)6月22日

優先権主張 ③1978年 6 月22日③西ドイツ (DE) ⑨ P2827471.7

②発 明 者 アンネローゼ・ゲーブルブンシ ユ

> ドイツ連邦共和国ベルリン21レ フエツオウシユトラーセ21

砂発 明 者 ゲルト・ヘプケ

ドイツ連邦共和国ベルリン31ョ ハンゲオルクシユトラーセ 3

⑫発 明 者 フエオドール・エストライヒヤ

ドイツ連邦共和国ベルリン12シ ユトウツトガルタープラツツ16

⑦出 願 人 シーメンス・アクチェンゲゼル シヤフト

> ドイツ連邦共和国ベルリン及ミ ユンヘン(番地なし)

邳代 理 人 弁理士 富村潔

明編書

- 1 発明の名称 液晶セルおよびその駆動方法
- 2 特許請求の範囲
 - 1) 液晶層が少くとも二種類の自転配向形成類 加物を含み、これらの影加物がそれぞれ一定 の温度範囲内にかいてネマテンタ基礎材料に 右回りあるいは左回りのねじりを発生させる ものであることを特徴とするネマテック基礎 材料と液晶にねじりによつて特徴づけられた コレステリック相を誘起するテラル影加物か ら成る液晶層が二つの支持板の間にはさまれ ている液晶もセル。
- 2) 誘起されたコレステリック相のねじりが一定の弧度範囲内で少くとも近似的に温度に無関係なビッテを持つようなテラル器加物が退ばれていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の液晶セル。
- 3) 終起されたコレステリック相のねじりが特 定の強度(To)を通過するときその回転方向

を変え、この温度にかいて無限大のピッチを 持つようなテラル級加物が選ばれていること を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の被 品セル。

- 4) 誘起されたコレステリック相のねじりが一定の温度範囲内で温度の上昇と共に一種類のチラル蒸加物だけが加えられているときより も急速に増大するビッチを持つようなチラル 蒸加物が選ばれているととを特徴とする作件 請求の範囲第1項記象の液晶セル。
- 5) 跨起されたコレステリック相のねじりが一定の温度範囲内で温度の上昇と共に一種類のチラル前加物だけが加えられているときよりも急速に減小するピッテを持つようなテラル 添加物が選ばれていることを特徴とする特許 請求の必勝第1項配象の液晶セル。
- 6) ターンオンしきい質電圧またはターンオフ しきい質電圧またはその双方が一定の温度範 助内で少くとも近似的に温度に無関係となる

(2)

(1)

ようなナラル最加物が選ばれていることを特象とする二つの異る光学状態の間で電気的に 切換え可能の液晶層を持つ特許請求の範囲第 1 項配載の液晶セル。

- 7) ターンオンしきい儀電圧またはターンオフ しきい値電圧またはその双方が一定の選定範 既内で少くとも近似的に温度に対して直接的 に変化することを特象とする異る光学状態の 即で電気的に切換え可能の液晶層を持つ特許 時次の範囲第1項配載の液晶をル。
- 8) 誘起されたコレステリック相とネマチック相との間で切換えられることを特徴とするネマチック基礎材料と液晶にねじりによって特徴づけられたコレステリック相を誘起するテラル最加物から成る液晶層が二つの支持板の間にはさまれている液晶セルの駆動方法。

(.)

- 10) 財起されたコレステリック相と一つのダイナミック制御相との間で切換えられることを特徴とする液晶セルの駆動方法。
- 11) 防起されたコレステリック相が弾性変形を 受けることを特徴とする液晶セルの駆動方法。
- 12) 誘起されたコレステリック相と印加物理量の減小または停止の限も保存される一つの相の間で切換えられることを特徴とする液晶セルの収動方法。

3 発明の詳細な説明

この発明はネマチンク基便物質と液晶相にわ じりで特徴づけられたコレステリック相を移起す る少くとも一種類のチラル最加物を含む液晶層が 二つの支持板の間にはさまれている液晶セルに関 するものである。この種のディスプレイは例えば

(4)

西独国特許出版公開第2727562号公報化配 載されているよう化多数の実施形態をもつて公知 である。

ネマチック液晶化デラル化合物をドープすると 特徴的なおじりが発生する。 このおじりのピッテ と回転方向はドープ物質のおじり性能(ヘリカル ッウイスチングパワー)とその硬度だけではなく 迅度にも曖保する。 これらのヘリックスパラメー メはそれ自体が砂起されたコレステリック副機の 位相変増しきい値電界等の重要な特性値に影響を 与えるものであるから例えば必要なスイッチング 電圧も動作品度によつて変化する。

このようなしきい鉱電圧変化は液晶ディスプレイを充分高い電圧レベルで制御すれば障害とはならないものであるが、このような手段は電力損失を高めるだけではなく多重化方式が可能のディスプレイではスイッテング電圧が上昇すれば過応答の危険が切大するため適用範囲が設定される。

そのためスイッチング電圧を動作温度に退従さ

せる方法が穏々検討されたがそれに適した制御過 時は一般に著しく複雑なものでありしきい値電圧 が一定の選度ドリフトを示すときに疑つて比較的 簡単に実現される。しかしてのような選度依存性 は跡起コレステリック相を持つ液晶にかいて実験 に認められたことはない。(温度に直接的に関係 するしきい値電圧について報告されたことがある が終てコレステリック成分から成る二成分混合物 についてのものである。)

この発明の目的は跨起されたコレステリック配向を持つ液晶層にかいてわじり(ジウィスト)が 規定の最度依存性を示すようにする方法とそれを 実現する手段を見出すことである。この温度関係 はある程度広い温度範囲で認められ、また比較的 広い範囲に互つて変化させられることが必要である。更にこの温度関係が調整可能であり他の液晶 パラメータの所望の温度依存性を導き得ることが 意数である。この目的を適成するためこの発明は 被品層に少くとも二番類のテラル都加物を含ませ、

(5)

(.)

この発明による多重ドーピングが誘起されたコ レステリング相の温度特性に与える影響は次のようなものである。

第一近似にないてヘリックスピッチの逆数は光学活性添加物の重量を化比例し、他方複数のチラル添加物の影響は加算的である。これからhiをi 音目の添加物のヘリカルックイスチングパワー、ci をその農炭(滅骨多)としてヘリックスピッチpは次の式:

$$\frac{1}{p} = \sum_{i=1}^{n} \text{ hici}$$
 (1)

で与えられる、

この式は弥加物がコレステリック類似であつてコレステリル時導体に属するとき一般に c > 2 0 重 量 ラ で無効になる。ネマチック類似のチラル蘇加物は 規在ドーブ物質として 推奨されているがそれに対しては近似式(I)が通常全機変範囲で適用され

特開 昭55-38 8 6 9(8) る。 温度に関係する量 hi を清澄点温度又は平均 動作温度付近でベキ級数に展開すると

$$hi = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^{j} \tau^{j-1} c_1$$
 (2)

となる。「は神経点温度 tm 又は平均動作温度
tm と実際の温度 tとの差ででt=t-tm 又は
r=t-tmである。

(2)によつて(1)を書き換えると

$$\frac{1}{p} = \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{i}^{j} r^{j-1} e_{i}$$
 (3)

和の順序を換えると

$$\frac{1}{p} = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^j \operatorname{ci} \right) r^{j-1} \tag{4}$$

一般に許されているように各ドーブ物質が勝起す るピッチの遊数が温度の上昇に伴つて直続的に低 下するとすれば(4)は

$$\frac{1}{p} = \sum_{i=1}^{n} (\alpha_{i}^{1} \alpha_{i} + \alpha_{i}^{2} \alpha_{i} \tau)$$
 (5)

となる。ここで α_1^1 と α_1^2 とは常に符号が逆であ

る。 二種類のチラル設加物の場合には(5)は次の通り簡単になる。

$$p = \frac{\alpha_1^1 c_1 + \alpha_2^1 c_2 + (\alpha_1^2 c_1 + \alpha_2^2 c_2) r}{\alpha_1^1 c_1 + \alpha_2^2 c_2) r} (6)$$

(n)によれば二種類の同じ向きに回転させるチラル 添加物をドープするとヘリンクスピッチの強度特 性は両載加物を一方だけを使用したときのヘリッ クスピッチの温度特性の中間に位置する。従つて 大きな変化はこの場合不可能である。ネマチック 基礎物質に右回転と左回転の添加物が将解してい るとべき級数の係数は次の符号を持つ。

$$\alpha_1^1 > 0, \quad \alpha_1^2 < 0$$
 $\alpha_2^1 < 0, \quad \alpha_2^2 > 0$

右向り 凡像系では右回転ドープ物質の $lpha_1^1$ は正となり、左回転ドープ物質の $lpha_1^1$ は負となる。従つて、 $\|lpha_1^2\mathbf{c}_1\|=\|lpha_2^2\mathbf{c}_2\|$

であると風度に無関係なヘリックスピッチが得られる。 又 $\mid \alpha_1^1 \mid c_1 \mid c_2 \mid c_2 \mid$ となるように健康を選ぶと $\tau=0$ でヘリックスの逆転が起る。 同様

にしてヘリックスピッチを重変上昇に伴つて一種 類のテラル化合物をドープしたときよりも急激に 増大又は減小させることができる。

へリンクスピンナが包皮に無勝係であるとしき い値電圧もこれらの昔が直接的関係にあるとき重 皮に無関係に一定である。この関係は一般にコレ ステリンク相がネマテンク相に移る電界に対して 成立する。完全に直続的でなくても場合によつて はへリンクスピンナの温度特性を適当に補正する ことにより一足のしきい値電界とすることができ

(I) 文の関係自体は以前からよく知られていて何 えば雑誌 "Mol. Gryst.and Liq. Gryst." 15、 1975、p. 27 に配敷されている。との文献 には更に回転能力が一般に重度に関係することが 示されている。この関係を計算によつて求めることは "Naturwissenschaften, 62, 1975、 8. 436 に発表されている。この論文の者者は 観測された温度特性を分子回転の秩序パラメータ

(,)

(10)

に及ぼす强度の影響に帰している。 しかしそれか ら迷かれた関係からは定量的に満足できる結果は 与えられない。最近発表された論文(Mol.Gryst. and Liq. Cryst. 42, 1977, p. 15)KH この関係の知識が括められているが、第一に訪起 されたコレステリツク組織は天然のコレステリッ ク相とは鼻つた挙動を示すこと。第二に誘起され たねじりの弧度特性を微鏡に表現する式を解析的 に深くことができるがその物理的の解明はまだな されていたいことが確甘されている。上記の文献 によればホスト物質中に党制的に作られたコレス テリンク配向現象は長い間活発を科学的の興味を 持たれていたがとの観測結果を利用して酵起され たねじりにある目的に母つた影響を与えることは 考えられていなかつた。特に回転性の具る敷加物 の冬度ドーピングにより特定の温度特性を選成し よりとする考えが示唆されることはなかつた、

この発明による多度ドーピングは多くの表示原 即に対して有利である。即ち多くの相転移効果例 (11) 特開 昭55-38 869(4) えば可逆相転移、ヒステレシスを伴う相転 (二 安定効果)、メモリ性能を持つ相転位化♪いてメ ーンオン又はメーンオフしきい鉄電圧に問題となる余地のない温度特性を与えることができる。

ッウイステッドネマテック効果に基くデイスブレイの場合容易に強度に無関係な一定のヘリックス・ピッチを投定することができる。 温度に無関係なしきい値電圧も実現町能であり、 静止状態のヘリックスピッテが短い穏その実現が容易である。

電界による変形に基くダイナミック型のデイス プレイにかいても耐度に無関係なしきい低電圧を 考えることができる。 無後に環境構造にかいての 彼か選択性の反射を利用する范領域表示装置を 度に対して安定化することも可能であると考えら れる。

図面についてこの発明を更に詳細に説明する。 第1図に示した液晶セルは前面支持板1、背面 支持板2、これらの支持板を連結する枠3かよび 両支持板と枠3によつてかこまれた室を満たす液 (12)

品層もから構成されている。支持板の向い合つた内面にはそれぞれ減電層と液晶分子を配列させる配向暦8と9が設けられている。前面の導電層は連続したダント戦棒6となり、背面の導電層は連続した背流電係7となつている。この表示セルは相転特効果に基くもので充分高い電圧を印加することにより時止状態にかいて誘起されたコレステリック配向がホメオトロピック・ネマテック配向がホメオトロピック・ネマテック配向がホメオトロピック・ネマテック配向で移る。印加電圧を下げて行くとこの相は最初の中そのまま保持され、第二しきい値以下に下るとねじられた出発状質に戻る。

この実施例の放益層は商品名 8 1 1 3 2 で呼ばれているメルク社のネマテンタ基礎物質に二種類のテラル化合物が添加されたものである。 添加材は共化メルタ社のもので商品名 C B 1 5 かよび 2LI 8 1 1 で呼ばれている。 参加材 8 1 1 3 2 枚三糖 効のフェニルンクロヘキサンの混合物である。 C れらの参加材の化学標準式は新 1 提化示されている。 資素加材の配質量比は C B 1 5 が 1 2 7 5

重量が、ZLI811が1063度ができる。第 2回の曲線11で示すようにターンオンしきい値 電圧は約~3でから+40での間で実質上一定で あるがメルク社の商品名を8で呼ばれているネマ チック基礎材に上配のCB15を683重分が、 ZLI811を633重角が加えたものは曲線12 で示すように10でから40でまでの狭い温度能 間でダーンオンしきい値電圧がほぼ一定である。

第3図には種々のドーブ物質を同じネマチック 基礎材(メルク社の "nematische Phase 4")に 溶解したもののヘリックスピッチの相対値(30℃ の値に対する比)を重度の陶数として示す。この ネマチック基礎材は二種類のアゾキシ化合物 CH20~N=M-〇-C4H9と CH2・〇-N=M-〇-C4H9と Cれらの物質に対するペキ級数の係数は第1数に まとめてある。第1数には使用されたチラル化合物の化学構設式と添加重量比が挙げてある。

(13)

特開 昭	55— 3 <i>8</i>	28	9/5
------	----------------	----	-----

第	【表
---	----

		M7 1 4X				第三表	
कुँड ग्रहा प्रका	α1·10 ³ (am·数带多)	α ₁ ² ·10 ⁵) (μα·重量素	α3·10 ⁷)(#m·重量系	(T) (E)	药物物	· · 構造式(名)· · C2H5	後度比 (直第5)
8996 SLI811 61082 CB 15 C 15	- 678 -154 - 853 -1030 197 553 - 994	536 694 616 758 -211 -223 988	747 865 677 225 - 785 004 817	750 773 757 753 754 754	1	CH-CH2-O-O-CH-N-O-CN CH3 CH-CH2-O-O-CH-N-O-CH- CH3 CH-CH2-O-O-CH-N-O-CH- CH3 C2H5 -O-OH2-CH	208
C c	-762 -441	117 · 253	-285 -136	749 759 760	8996 £ ZLI811	CH-CH ₂ -O-O-C-B-O-CH CH ₃	157
	以下	ி . த		*;	j	CH ₂ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	046
					CB 15	он ₃ он-он ₂ -О-О-сы одн ₈	073 .
		(15)			C 15	CH3 OB-OH2-O-〇-〇-CH O2H5 コレステリル1+1アート 塩化コレステリル (18)	178 030 039

測定値曲線と表の値から個々の場合にどのドーブ物質が有利であるかを判定することができる。 その際各ドーブ物質のねじり性能は基礎材の特性 にも開係することを注意しなければならない。一 般にヘリカルツウイステングパワーの強い方が低 い最度ですみ、結果としてのねじりが近似式(1)に よつて最も良く記述することができるため有利で ある。

第4図は同じく30℃の値に対する比として
*nematische Phase 4*と添加物に B 15 かよ
び ZLI 811の混合物のヘリックスピッチの大き
さを示す。ここでは両チラル化合物の濃度比 c (
= ZLI 811の濃度/(ZLI 811の濃度+CB
15の濃度))がパラメータにとつてある。 測定
値曲報から混合比の値かの変化により既にヘリッ
クスピッチの温度特性が大きな影響を受けること
が分る。 c = 0 29(ZLI 811 と CB 15 の濃度
度はそれぞれ0379重量多と0908重量多)
のときピッチは68 #=で-10℃から+60℃

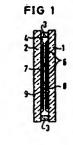
の範囲で±3 %まで一定である。 ZLI 8 1 10割 合を = 0 3 4 となるまで高めるとピッテは温度 が高くなるにつれて小さくなる。 ZLI8 1 1 の機 変を高くして = 0 3 6 にすると極端に急峻な振 点を特徴とするヘリックス構造となり更に機度を 値かに高くして = 0 3 7 とするとピッテは温度 上昇に伴つて急散に増大する。

この発明は上配の実施例に限定されない。例えば所望の温度特性を達成するため二種類だけでは なくそれ以上の右回転すたは左回転の添加材また はその尚方を加えることができる。又被晶セルを 世形以外の物類量で制御してもよい。例えば既非 が考えられる。一般的に言つてこの発明は液晶デ イスプレイの温度に関係する特性値をヘリックス パラメータの温度特性を変えることによつて適当 な温度特性とする場合に有利である。例えばIO として構成された制御ユニットの温度ドリフトを 液晶と適当な多重ドーピングにより阻止すること ができる。

(17)

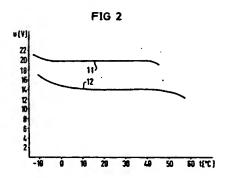
(18)

第1回はこの発明の対象となる液晶セルの断面を示し、第2回はこの発明による液晶セルのターンオンしきい値電圧の速度特性、第3回と第4 図は種々の混合液晶材料のヘリックスピッチの温度特性曲線を示す。第1回にかいて1と2は支持板、3は支持板凍結枠、4は液晶層、6と7枚電板、8と9は液晶分子配向層である。



特朗 昭55-38 8696)

(6118) 代理人 弁理士 資村 古



(19)

